ИЗВЕСТИЯ

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА имени С. М. КИРОВА

Том 162

1967

ВЛИЯНИЕ _У-ОБЛУЧЕНИЯ НА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИК НА ОСНОВЕ ТИТАНАТА БАРИЯ

Г. А. УРАЛОВ

(Представлена научным семинаром научно-исследовательского института ядерной физики)

Исследованию свойств монокристаллов и керамик титаната бария посвящено большое число работ [1-4]. Но, несмотря на большой интерес к титанату бария, влияние ионизирующего излучения на BaTiO₃ и керамики на его основе в настоящее время почти не исследовано. Имеющиеся работы описывают поведение титаната бария под действием нейтронного облучения [5]. Влияние же γ -квантов на керамики на основе титаната бария в настоящее время еще не изучено.

Широкое применение керамики на основе титаната бария могут найти в электронике СВЧ [6] и ускорительной технике [7]. В последнем случае керамика будет работать в поле ү-излучения. Поэтому представляет интерес исследовать влияние ү-излучения на электрические свойства керамик в диапазоне СВЧ.

Электрические свойства материалов можно характеризовать двумя величинами: проницаемостью є' и тангенсом угла потерь tg δ. Так как эти величины связаны с проводимостью, то они должны меняться под действием ионизирующего излучения.

В настоящей работе описываются экспериментальные результаты исследования свойств керамик на основе титаната бария под действием γ -излучения от источника Со⁶⁰ в диапазоне СВЧ ($\lambda = 10 \ cm$).

Для измерения ε' и tg δ керамик в поле γ-излучения была создана установка, удовлетворяющая следующим требованиям:

 установка должна позволять дистанционно измерять диэлектрики с большими значениями диэлектрической проницаемости. Это требование вытекает из соображений радиационной безопасности;

2) установка должна позволять одновременно измерять проницаемость и тангенс угла потерь. Это требование вытекает из того, что образцы обладают определенным разбросом в ε' и tg δ , а также из того, что tg $\delta = f(\varepsilon')$;

3) для повышения точности измерения необходимо измерять величины, которые зависят от ε' и tg δ , в возможно меньший отрезок времени.

Для измерения проницаемости и потерь диэлектриков с большими є' наиболее приемлемыми оказываются резонансные методы [8]. Блок-схема установки показана на рис. 1. Требование дистанционного измерения приводит к тому, что в линиях связи установки будет теряться значительная доля энергии в. ч. генератора. Поэтому был выбран генератор 1 с большим уровнем мощности на выходе (ГС-22). Сигнал от в. ч. генератора через аттенюатор 2 поступает на резонатор 3, который представляет собой прямоугольный резонатор на волне H_{10} с частичным заполнением исследуемым диэлектриком. Исследуемая керамика марки T-80 и T-150



Рис. 1. Блок-схема установки: 1 — генератор в. ч. имплуьсов (ГС-22), 2 — аттенюатор, 3 — резонатор, 4 — детектор, 5 — осциллограф, 6 — генератор прямоугольных импульсов, 7 — линия задержки

изготовлена в виде прямоугольных пластин с сечением, равным сечению резонатора, и толщиной, близкой к четвертьволновому слою. Располагается пластина на расстоянии 1 мм от торца резонатора. Это связано с тем, что, как показали расчеты, в этом случае будет наибольшая точность измерения ε' и tg δ диэлектриков при больших значениях проницаемости. Сигнал с резонатора через детектор 4 поступает на вход осциллографа 5.

Чтобы выполнить требование кратковременности измерения резонансной частоты и добротности, в установке использовалась модификация метода декремента затухания [9], которая позволяет быстро измерять параметры низкодобротных резонаторов. Этой цели служат генератор прямоугольных импульсов 6 и линия задержки 7. Отрицательный импульс с генератора 6 через линию задержки 7 поступает на модулирующий электрод осциллографа 5, а положительный на модуляцию в. ч. генератора 1. В качестве генератора прямоугольных импульсов и линии задержки использовались стандартные приборы 26И и МГИ-1 соответственно.

Как показали расчеты, с помощью описанной схемы можно измерять проницаемость и тангенс угла потерь с максимальной погрешностью 5 и 30 % соответственно.

Описанная выше установка позволила провести исследования по изменению электрических свойств керамик на основе титаната бария в диапазоне СВЧ до, во время и после облучения. Источником γ-квантов служил Со⁶⁰ гамма-установки института ядерной физики АН УЗССР. Эксперименты проеодились при температуре 28°С. Экспериментальные результаты представлены на рис. 2—4.

На рис. 2 показано изменение отношения тангенса угла потерь в поле γ -излучения tg δ к тангенсу угла потерь до облучения tg δ_0 в зависимости от логарифма интегральной дозы 1g D при мощности дозы 11 *p/сек*. Как видно из рис. 2, в интервале доз 10³—10⁷ *p* отношение tg $\delta/tg \delta_0$ остается постоянным. Весьма возможно, что начальная точка 1 сдвинута влево в связи с тем, что время облучения до интегральной дозы 10³ *p* мало и снять экспериментальные точки в этой области оказалось невозможно. Аналогично время отжига (здесь и далее имеется в виду временной отжиг) после облучения (точки 2—3) тоже мало и для данной мощности дозы в диапазоне доз $10^3 - 10^7 p$ не превышает двух минут. Причем tg δ падает до значения, соответствующего необлученным образцам.



Рис. 2. Зависимость отношения тангенсов угла потерь от дозы облучения (мощность дозы 11 *p/cek*) С увеличением интегральной дозы время отжига увеличивается, как показано на рис. 3, но в исследованном интервале доз значения тангенса угла потерь в пределах ошибки эксперимента спадают до первоначального значения.

Интересно отметить, что тангенс угла потерь зависит не только от интегральной дозы, но и от мощности дозы. На рис. 4, а показана зависимость тангенса угла потерь от временного отжига при различных мощностях дозы при

интегральной дозе $2.10^7 p$, а на рис. 4, б — при интегральной дозе $2,2.10^8 p$.

Заметим, что начальное значение тангенса угла потерь $tg \delta_0$ для образцов, облучаемых в поле с мощностью дозы 270 $p/ce\kappa$, несколь-



Рис. 3. Влияние отжига на тангенс угла потерь в зависимости от интегральной дозы облучения (мощность дозы 425 p/cek)

ко больше, чем начальные значения tg δ_0 для образцов, облучаемых в поле с мощностью дозы 425 *p/сек*. Учитывая это, можно видеть, что время "отжига" в этих случаях примерно одинаково. Из рис. 4, *a* и 4, б можно сделать вывод, что число дефектов растет с ростом мощности дозы ионизирующего излучения. Очевидно, это связано с временным отжигом во время облучения. Что касается проницаемости, то никаких изменений ее при дозах до 2.10⁸ *p* обнаружено не было.

Наиболее важным эффектом действия на диэлектрики у-излучения, как и рентгеновских лучей, является процесс ионизации. Кроме этого, часть энергни, приносимая у-квантами, может расходоваться на смещение атомов и на эффекты, предложенные Зейтцем и Варли [10]. Тот факт, что тангенс угла потерь после облучения в поле у-излучения дозой до 2.108 р восстанавливается до первоначального значения, говорит о том, что смещение атомов и эффекты Зейтца и Варли в этом интервале доз весьма незначительны. О том же говорит и то, что при данных дозах проницаемость образцов не меняется.



Рис. 4. Наличие отжига на тангенс угла потерь в зависимости от мощности дозы облучения:

a-интегральная доза $2 \times 10^7 p$, δ — интегральная доза $2,2 \times 10^8 p$.

Таким образом, в результате у-облучения керамик на основе титаната бария наблюдается увеличение тангенса угла потерь, которое пропорционально не только интегральной дозе, но и мощности дозы. После облучения эти эффекты исчезают с течением времени.

. ЛИТЕРАТУРА

Ю. М. Поплавко. ФТТ, 4, № 4, 1069, 1962.
Ф. Ф. Коджеспиров. Сб. «Физика диэлектриков». М., АН СССР, 1960.
В. М. Гуревич, И. С. Рез. ФТТ, 2, № 4, 673, 1962.
Г. А. Липаева, Г. И. Сканави. ФТТ, 2, № 3, 506, 1960.

5. Воздействие радиоактивного излучения на электроизоляционные материалы. Госэнергоиздат, М.-Л., 1959.

6. Ю. М. Поплавко. ФТТ, 4, № 9, 2606, 1962.

7. А. А. Воробьев, Л. Н. Безматерных, А. Н. Диденко, А. И. Лисицын. А. П. Ольшанский. Изв. вузов, Радиофизика, т. VII, № 2, 338, 1964.

8 А. А. Брандт. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах. ГИЗ ФМЛ, М., 1963. 9. П. И. Госьков, П. И. Матяж. Измерение низкочастотных резонаторов. Ав-

торское свидетельство № 171030, БИТЗ № 10, 1965.

10. Дж. Дине, Дж. Виниард. Радиационные эффекты в твердых телах. ИЛ, 1960.